表面のふく射性質の測定

若林英信

- (1) ふく射伝熱評価
 (2) 2方向反射率の測定…
 (3) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の開発… RNNと
 - (4) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の拡張 … R NH と N

N

表面のふく射性質の測定

若林英信

(1) ふく射伝熱評価
(2) 2方向反射率の測定…
(3) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の開発… RNNと N
(4) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の拡張… RNHと N



熱ふく射 thermal radiation

Planck 分布の及ぶ広い波長域 / 可視 ~ 赤外

指向性の弱い/拡散的なふく射

…レーザのふく射のように単色ふく射がビーム的に直進するものではなく

偏光性は強いものではない









ふく射を不完全に拡散反射する

... 鏡面反射的にでもなく 完全拡散反射的にでもなく

表面状態は一意的に定義されず / 時々刻々にも変化しうる …工業的な表面加工プロセスでは積極的に変化させられる



! 系におけるふく射の伝搬をとり扱うのは易しくない

! 放射率などの表面のふく射性質の値を

その表面の環境に応じてあらかじめ推定するは難しい

ふく射伝熱評価の伝統的な方法

【方向特性】完全拡散の仮定



(1) 表面が放射するふく射の等方性 …完全拡散放射

(2) 表面に入射するふく射の等方性 …半球等強度入射

(3) 表面が反射するふく射の等方性 …完全拡散反射

【波長特性】
 灰色体の仮定

(4) 表面のふく射性質が波長に依存しない

形態係数・温度・全半球放射率

(系における表面の配置) (...表面のふく射性質を代表する)

(...教科書・資料集にはその値がリストされる



伝統的な方法の問題点

... 適切に評価できない / 確かでない 温度の有効数字 の 1桁め ふく射エネルギーの オーダ

... ふく射の方向分布と波長分布についての仮定の乱暴さ

完全拡散 灰色体

ふく射の方向分布の仮定の乱暴さ ... 温度分布・表面の反射の方向特性

完全拡散

(1) 表面が放射するふく射の等方性 …完全拡散放射
 ×(2) 表面に入射するふく射の等方性 …半球等強度入

×(3) 表面が反射するふく射の等方性 …完全拡散反射



ふく射の波長分布の仮定の乱暴さ ... 系に強い温度分布がある場合に顕著になる

灰色体



 $\mathcal{E}_{\mathrm{H}}^{\mathrm{t}}$ $A_{\mathrm{H}}^{\mathrm{t}}$ (全半球放射率) (全半球等強度入射吸収率

cf.

Kirchhoffの法則が成立するとすれば (分光指向放射率) = (分光指向入射吸収率)





黒体の分光放射強度(スペクトル) … Planckの式 $I_{\rm B} = I_{\rm B}(\lambda, T)$

 $=\frac{1}{\pi}\frac{C_{1}}{\lambda^{5}}\frac{1}{\exp(\frac{C_{2}}{\lambda T})-1}$ $C_{1}=3.7415\times10^{-16}\text{W}\cdot\text{m}^{2}$ $C_{2}=0.014388\text{m}\cdot\text{K}$

縦軸・横軸が対数目盛なので,

一見すると

98%も占めるようには見えないが...



分光垂直放射率(スペクトル) = 分光垂直入射吸収率(スペクトル)



全半球放射率 0.3 全半球等強度入射吸収率 0.9

われわれの実験試料/ われわれが分光測定した 酸化ニッケル被膜つきニッケル表



熱工学の問題を改善するには

ふく射の【方向分布】と【波長分布】を考慮

... 評価の目的に照らして

ある程度 乱暴な方法をとる



... ふく射伝熱の評価につながる研究



- 適度に厳密に記述する方法 -

研究の方針

【**方向特性】**半球反射率の鏡面反射成分と完全拡散反射成分 【**波長特性】**多段の階段状のスペクトルモデル

【縦軸】 Wの単位の量

表面のふく射性質の測定

若林英信

- (1) ふく射伝熱評価
 (2) 2方向反射率の測定…
 (3) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の開発… RNN と
 - (4) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の拡張 … R NH と N

N

【課題】

表面に方向分布をもって入射するふく射が不完全に拡散反射される現象を 簡潔に記述し,

工学系における個々の表面が吸収するふく射エネルギーを Wの単位で評価できるようにする 方法を示すことである.









<さまざまのあらさをもつあらい表面・個々のあらい表面について> 2方向反射率 (の分布)を測定する・ 分布の実験値 ------を得る 分布を 4個(or 3個)の少数のパラメータを含む計算式により表現する

分布の実験値を計算式に curve fitして4 個(or 3 個)の少数のパラメータを決定する

(₁方向入射)半球反射率 *R*H (= *R*s+ *R*d)・ 鏡面反射成分 *R*sと完全拡散反射成分 *R*d を を用いて計算する

エネルギー保存 *A*+*R*H=1から (₁方向入射)吸収率*A*がわかる!

【評価】なんW?

不完全に拡散反射的な 実在表面 の典型例として もっとも単純で代表的な反射特性研究の対象として



金属の裸のあらい表面

ステンレス鋼 JIS-SUS304 湿式研摩 JIS-mesh 240 ~ 3000 砥粒 ______ あらい なめらか

$$2\mu\mathrm{m} = \frac{100\,\mathrm{\mu}\mathrm{m}}{100\,\mathrm{\mu}\mathrm{m}}$$

rms あらさ Σ = 1.5 µm(あらい) ~ 0.095 µm(なめらか) 自己相関長さ τ_0 (Σ)

入射ふく射の 波長 $\lambda = 0.6328 \,\mu m(vis) \& 3.39 \,\mu m(ir)$ 光学あらさ $\Sigma/\lambda = 2.4$ (あらい) ~ 0.028(なめらか) 広い光学あらさ域



2 方向反射率
$$\rho$$

 $\rho = \rho(\theta_{1}, \phi_{1}, \theta_{R}, \phi_{R})$ I_{R} 反射されるふく射の強度
 $= I_{R}/q_{1}$ q_{1} 単位面積あたりに入射する
 $= I_{R}/\int_{\Delta \Omega I} I_{1} \cos \theta_{1} d\Omega_{1}$ q_{1} 単位面積あたりに入射する
 $\Lambda < 射のエネルギー$
 $R_{H} = R_{H}(\theta_{1}, \phi_{1})$
 $= \int_{I_{R}} I_{R} \cos \theta_{R} d\Omega_{R} / \int_{\Delta \Omega I} I_{1} \cos \theta_{1} d\Omega_{1}$
 $= \int_{hemisphere} \rho \cos \theta_{R} d\Omega_{R}$
 $= \int_{-\pi}^{\pi} \int_{0}^{\pi/2} \rho \cos \theta_{R} \sin \theta_{R} d\theta_{R} d\phi_{R}$
 $= \int_{0}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi/2} \rho \cdot (\sin \theta_{R} d\phi_{R}) \cdot d(\sin \theta_{R})$
 $\mathbf{E} \mathbf{E}$
 $(q_{1} \cdot \Delta A) = I_{1} \cos \theta_{R} \cdot \Delta A \cdot \Delta \Omega_{1}$
 $(q_{R} \cdot \Delta A) = I_{R} \cos \theta_{R} \cdot \Delta A \cdot \Delta \Omega_{R}$
 $\Delta \Omega_{R} = \Delta S / \ell^{2}$

ふく射のエネルギー

 $\rho = I_{\rm R}/q_{\rm I}$ ={ $(q_{\rm R} \cdot \Delta A)/(q_{\rm I} \cdot \Delta A)$ } · (1/cos $\theta_{\rm R}$) · ($\ell^2/\Delta S$)



1. laser $\begin{cases} vis \ 0.6328 \ \mu m \\ ir \ 3.39 \ \mu m \end{cases}$

- 2. laser expander
- **3. optical chopper**
- 4. specimen surface
- **5.** optical detector \int vis Si photodiode

ir HgCdTe photoconductive detector



(鏡面反射性が強くない) ANDモデル



 $\rho = \rho(\theta_{\rm R}, \phi_{\rm R}; A, \sigma, \rho_{\rm d}, \theta_{\rm Rmax})$ $=\rho_{\rm s}+\rho_{\rm d}$ $\rho_{\rm s} \cos \theta_{\rm R} = A \cdot \exp\{-f^2/(2\sigma^2)\} \cdot \cos\{(\pi/2) \cdot (f/g)^2\}$ $(\theta_{R}, \phi_{R}) = (\theta_{Rmax}, 0)$ のとき, *f*=0, *g*=(実数)≠0 $(\theta_{R}, \phi_{R}) \neq (\theta_{R_{max}}, 0)$ のとき, $f=(p^2+q^2)^{1/2}$ $g = \{-kp + (f^2 - k^2q^2)^{1/2})\}/f$ $p = \sin \theta_{\rm R} \cos \phi_{\rm R} - k$ $q = \sin \theta_{\rm R} \sin \phi_{\rm R}$ $k = \sin \theta_{\text{Rmax}}$

(鏡面反射性が強い) 円錐モデル





 $0 \le \alpha \le \alpha_h$ のとき, $\rho_s \cos \theta_R = (\rho \cos \theta_R)_{max} (1 - \alpha / \alpha_h)$

 $\alpha > \alpha_{\rm h}$ のとき , $\rho_{\rm s} \cos \theta_{\rm R} = 0$

目的関数 - 最小2 乗処理 -

$$F^{2} = \sum_{j} w_{j} \{ (\rho \cos \theta_{R})_{j}^{\text{calc}} - (\rho \cos \theta_{R})_{j}^{\text{exp}} \}^{2}$$
$$w_{j} = (\Delta \Omega)_{j} / \sum_{j} (\Delta \Omega)_{j}$$

(」方向入射)半球反射率 $R_{H}(=R_{s}+R_{d})$

$$R_{\rm H} = R_{\rm s} + R_{\rm d}$$

$$R_{\rm s} = \int_{\phi_{\rm R}=0}^{360^{\circ}} \int_{\theta_{\rm R}=0}^{90^{\circ}} \rho_{\rm s}(\theta_{\rm I}, \theta_{\rm R}, \phi_{\rm R}) \cdot \cos\theta_{\rm R} \sin\theta_{\rm R} d\theta_{\rm R} d\theta_{\rm R} d\phi_{\rm R}$$

 $R_{\rm d} = \pi \rho_{\rm d}(\theta_{\rm I})$

specimen No.	$ heta_{ m I}$	A	σ	$ ho_{ m d}$	F	R_{s}	R _d	$R_{\rm H}$	$R_{\rm s}/2$
	0	sr ⁻¹		sr ⁻¹	sr-1				
1(vis)	0	0.19	0.41	0.22	0.004	0.21	0.71	0.91	0.
	20	0.17	0.44	0.19	0.009	0.20	0.60	0.80	0.
	40	0.24	0.45	0.17	0.010	0.25	0.54	0.80	0.
	60	0.36	0.38	0.14	0.023	0.28	0.46	0.74	0.
2(vis)	0	0.21	0.62	0.17	0.002	0.36	0.54	0.91	0.
	20	0.21	0.57	0.15	0.006	0.33	0.47	0.80	0.
	40	0.27	0.49	0.14	0.010	0.35	0.45	0.80	0.
	60	0.42	0.36	0.14	0.021	0.30	0.45	0.75	0.
3(vis)	0	0.60	0.28	0.16	0.022	0.36	0.53	0.89	0.
	20	0.60	0.26	0.17	0.065	0.31	0.53	0.86	0.
	40	0.60	0.30	0.16	0.46	0.38	0.53	0.91	0.
	60	0.94	0.19	0.27	3.9	0.30	0.88	1.18	0.2
		↓ 61.0	0.013	0.25	0.16	0.01	0.79	0.80	0.
1(ir)	0	0.50	0.26	0.17	0.031	0.27	0.56	0.82	0.
	20	0.48	0.33	0.13	0.032	0.37	0.41	0.78	0.
	40	0.77	0.20	0.17	0.049	0.26	0.53	0.80	0.
	60	1.67	0.13	0.14	0.37	0.28	0.46	0.76	0.
2(ir)	0	0.64	0.17	0.21	0.015	0.31	0.68	0.83	0.
	20	0.43	0.30	0.17	0.071	0.15	0.54	0.83	0.
	40	0.69	0.17	0.18	0.39	0.28	0.57	0.75	0.
	60	0.94	0.15	0.27	1.33	0.18	0.68	0.90	0.
		↓ 135	0.013	0.25	0.14	0.22	0.78	0.82	0.
3(ir)	0	↓ 389	0.031	0.098	0.036	0.38	0.31	0.69	0.
	20	↓ 444	0.027	0.10	0.053	0.34	0.32	0.66	0.
	40	↓ 542	0.025	0.094	0.054	0.35	0.30	0.65	0.
	60	↓ 875	0.024	0.090	0.041	0.55	0.28	0.83	0.
specimen No.	$\theta_{\rm I}$	$(\rho \cos \theta_{\rm R})_{\rm max}$	α _h	ρ _d	F	R _s	R _d	R _н	R _s /
	0	sr ⁻¹	rad	sr ⁻¹	sr ⁻¹				



表面のふく射性質の測定

若林英信

- (1) ふく射伝熱評価
- (2) 2方向反射率の測定 ...
- (3) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の開発 … R NN と N
- (4) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の拡張 … R NH と N

【課題】

工業装置の実環境下にあって

そのふく射性質が時々刻々にも変化する実在表面の現象を 系統的に研究する方法を示すことである.



広波長域高速ふく射スペクトル測定装置

(a) **広い波長域**

- 可視~赤外の
- --- Planck distribution for heat transfer
- --- order of surface microstructure

(b) **推移する現象**

- くり返し測定 サイクル時間:数秒
- --- transient radiation phenomena
- --- real-time in-process surface diagnosis

(c) 反射と放射

- 反射・放射同時測定
- --- absorption and emission of radiation
- --- hemispherical reflection by surface microstructure





------ Spectrophotometer ------

wavelength : 0.30 - 11 µm at 93 points cycle time : 2 s spectra : reflection, emission R_{NN} N optics, sensors: 4 gratings, 7 motors, 99 detectors





- 1. tungusten-halogen lamp
- 2. Si_3N_4 light source
- 3. rotationary concave mirro
- 4. shutter disk
- 5. specimen
- 6. K-thermocouple
- 7. heater
- 8. concave mirror
- 9. rotationary plane mirror
- 10. chopper
- 11. entrance slit
- 12. filter disk
- 13. rotationary plane mirror 1
- 14. rotationary plane mirror 2
- 15. collimator
- 16. diffraction grating
- 17. camera mirror
- 18. 35-Si photodiode array
- 19. 16-Ge photodiode array
- 20. 32-InSb
 - photovoltaic array
- 21. 16-HgCdTe photoconductive array

wavelength region	ength region µm		1	.1 1.	8 5.		.5 11	
light source	tungsten-halogen lamp			silicon nitride light source				
diffraction grating								
blaze wavelength	μm	0.80		1.25	3.20		6.79	
number of grooves	/mm	200		150	41		12	
higher-order light cut-filter								
cut-on wavelength	μm	0.30	0.57	0.90	1.7	3.3	5.5	
detector element array	(Si)		(Ge)	(InSb)		(HgCdTe)		
element		silicon photodiode		germanium photodiode	InSb photo- voltaic detector		HgCdTe photo- conductive detector	
element size	mm	W0.9 × H4.4		W0.8 × H1.0	W1.0 × H1.0		W1.0 × H1.0	
element spacing	mm	0	.1	0.2	0.	25	0.3	
number of elements	35		16	32		16		











2000 ,







Kirchhoff : $\varepsilon_N = A_N$ Energy : $R_{NH} + A_N = 1$ $R_{NN} < R_{NH} = 1 - \varepsilon_N$

diffuse reflection

 \rightleftharpoons surface microstructure

表面のふく射性質の測定

若林英信

- (1) ふく射伝熱評価
- (2) 2方向反射率の測定 ...
- (3) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の開発 ... R NN と N
- (4) 広波長域高速ふく射スペクトル測定装置の拡張 … R NH と N

放射率・反射率 (われわれの実験装置では 垂直 15°) 垂直放射率 N 垂直入射垂直反射率 R NN 垂直入射半球反射率 RNH 半球等強度入射垂直反射率 R HN 半球等強度入射半球反射率 R HH 半球放射率 H エネルギー保存・Kirchhoffの法則 A N + R NH = 1 N = A NN + R NH = 1

A H + R HH = 1

Helmholtzの相反則 *R*NH = *R*HN



- 1. tungusten-halogen lamp
- 2. Si₃N₄ light source
- 3. paraboloidal mirror 1
- 4. paraboloidal mirror 2
- 5. specimen
- 6. heater



半球等強度入射垂直反射率

$$R_{\rm HN} \equiv \frac{I_{\rm s}}{I_0}$$





 $v_{\rm s} = l_{\rm s} A \cos_0 v_{\rm r} = R(_0) l_0 A \cos_0$ $R_{\rm HN} \equiv \frac{l_{\rm s}}{l_0} = \frac{V_{\rm s}}{V_{\rm r}} R(_0)$

small reference blackbody



- · ID ϕ 20 mm × 50 mm
- · diaphragm: ϕ 10 mm
- material: SUS304
- · sheath heater: ϕ 1 mm
 - ... 3 circuits: base, body & neck
- · thermocouple: K ϕ 0.1mm
 - ... at base, body & neck
- calib. temps.: 1000, 1050 and 1100 K
- emittance: 0.99





- 1. tungusten-halogen lan
- 2. Si₃N₄ light source
- 3. paraboloidal mirror 1
- 4. paraboloidal mirror 2
- 5. specimen
- 6. heater
- C. cam mechanics
- 7. concave mirror
- 8. plane mirror
- 9. rotationary plane mirro
- 10. chopper
- 11. entrance slit
- 12. filter disk
- 13. rotationary plane mirro
- 14. collimator
- 15. diffraction grating
- 16. camera mirror
- 17. 35-Si photodiode array
- 18. 16-Ge photodiode arra
- 19. 32-InSb

photovoltaic array

20. 16-HgCdTe

photoconductive array



ニッケル (初期状態=光学鏡面)



ニッケル (初期状態=光学鏡面)



クロム (初期状態=光学鏡面)



ニッケル (初期状態=あらい表面)



クロム (初期状態=あらい表面)



